

## TO 系列探测器

### 产品简介

TO 系列产品是在 InP 衬底上用 MOCVD 方法生长 InGaAs 光吸收区，再经平面扩散工艺制备而成。光敏面尺寸分别是：  
 $\phi 300\mu\text{m}$ 、 $\phi 500\mu\text{m}$ ，用户可根据需求选择合适的器件。



### 应用范围

- 近红外波段光学计量
- 光功率光学检测
- 光纤损耗测量
- 光谱测量
- 微光测量

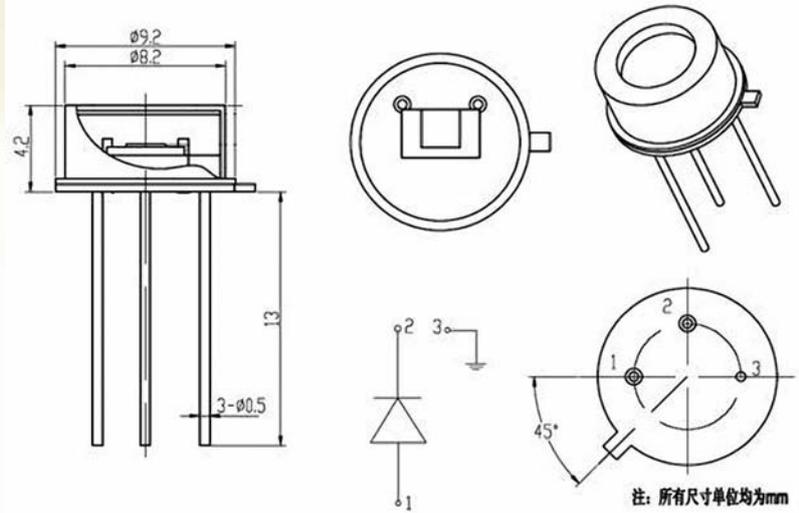


## 技术指标 (20℃)

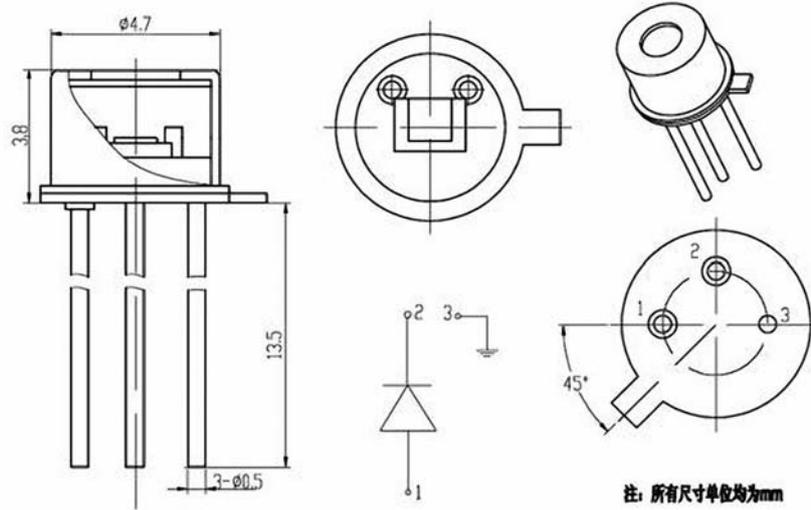
TO 系列光电探测器				
参数		Φ300μm	Φ500μm	单位
封装形式		TO 封装		-
响应波长范围		0.65 ~ 1.65		μm
响应度 (0V)	1310nm	≥ 0.75		A/W
	1550nm	≥ 0.80		A/W
线性范围 (0V)	-	-40 ~ 10		dBm
电容(-5V)		≤ 12	≤ 20	pF
暗电流(-5V)		≤ 5	≤ 10	nA
工作电压		0 ~ -10		V
线性度		± 0.15	± 0.15	dB
插接偏差		± 0.1	± 0.1	dB
插接寿命		10 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>	次
最大不饱和功率		> 3	> 3	dBm
正向电流		10		mA
光电流		10		mA
反向偏压		25		V
功耗		100		mW
工作温度		15 ~ 60		℃
存储温度		-10 ~ 60		℃
焊接条件		260 (10sec)		℃



封装外形图



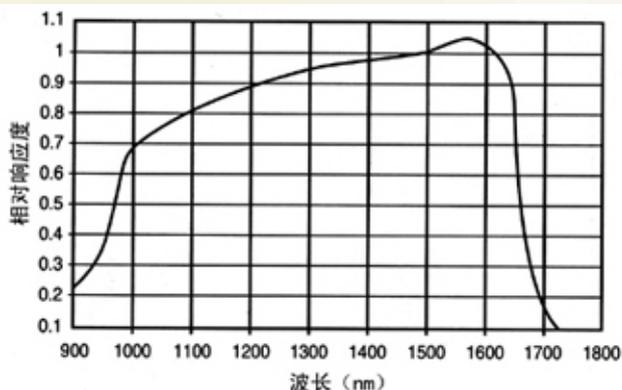
TO9 平窗管壳外形图



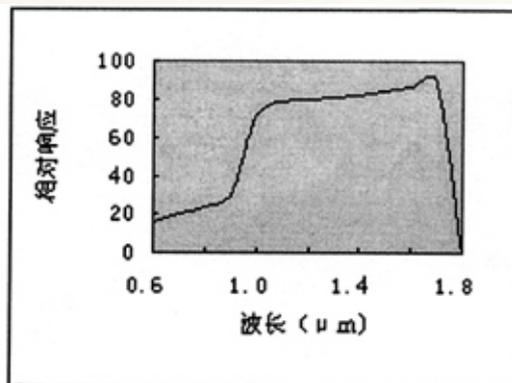
TO46 平窗管壳外形图



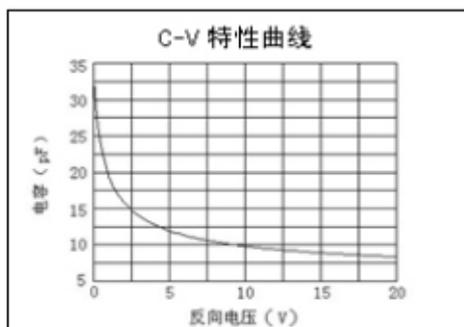
## 参考曲线



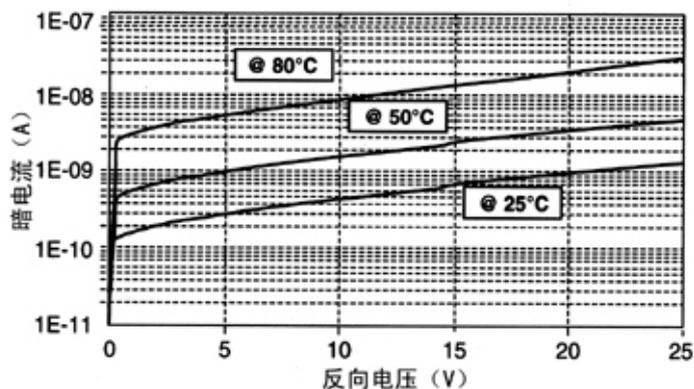
典型光谱响应曲线 (PIN30713)



典型光谱响应曲线 (PIN30723)



C-V特性曲线



暗电流特性曲线

- 1、上述特性曲线是某型号的曲线，仅作参考，具体以随探测器附带的测试数据为准。
- 2、如有更多信息需求请联系海特光电有限责任公司。

